

Title (en)

FET CHIP WITH HEAT-EXTRACTING BRIDGE.

Title (de)

FELDEFFEKTTRANSISTOR-SUBSTRAT MIT WÄRMEFÜHRENDER BRÜCKE.

Title (fr)

PUCE A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP AVEC PONT D'EXTRACTION DE CHALEUR.

Publication

EP 0627124 A1 19941207 (EN)

Application

EP 94905947 A 19931221

Priority

- US 9312495 W 19931221
- US 99482292 A 19921222

Abstract (en)

[origin: WO9415361A1] Semiconductor with field effect transistors therein has a substantial metallic source bridge joining the adjacent FET sources. The source bridge is mounted against a heat extracting support to both support the FET and cool it.

Abstract (fr)

L'invention se rapporte à une puce de semiconducteur dans laquelle sont incorporés des transistors à effet de champ et qui comprend un pont de source essentiellement en métal reliant les sources de transistors à effet de champ adjacentes. Le pont de source est monté contre un support d'extraction de chaleur, qui sert à la fois à soutenir les transistors à effet de champ et à les refroidir.

IPC 1-7

H01L 23/36; **H01L 23/48**; **H01L 29/52**; **H01L 29/784**

IPC 8 full level

H01L 23/36 (2006.01); **H01L 21/338** (2006.01); **H01L 23/367** (2006.01); **H01L 23/538** (2006.01); **H01L 29/417** (2006.01); **H01L 29/812** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01L 23/367 (2013.01); **H01L 23/5381** (2013.01); **H01L 29/41725** (2013.01); **H01L 2924/0002** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 9415361A1

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

WO 9415361 A1 19940707; AU 5985694 A 19940719; AU 668463 B2 19960502; CA 2117460 A1 19940707; EP 0627124 A1 19941207; IL 108151 A0 19940412; JP H07505016 A 19950601

DOCDB simple family (application)

US 9312495 W 19931221; AU 5985694 A 19931221; CA 2117460 A 19931221; EP 94905947 A 19931221; IL 10815193 A 19931222; JP 51541994 A 19931221